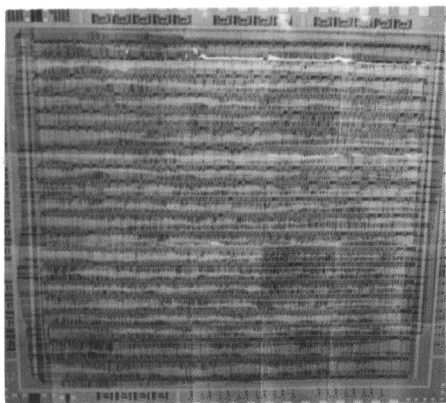
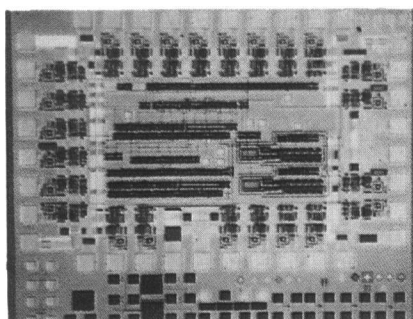


# 超大规模集成电路工艺技术研究室



← 采用0.8微米单层金属布线工艺设计的工业控制专用集成电路。



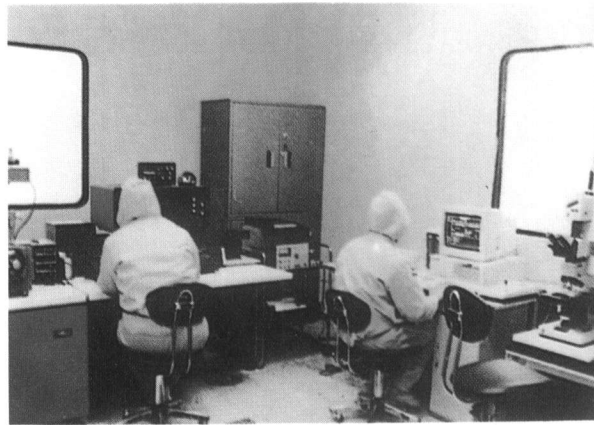
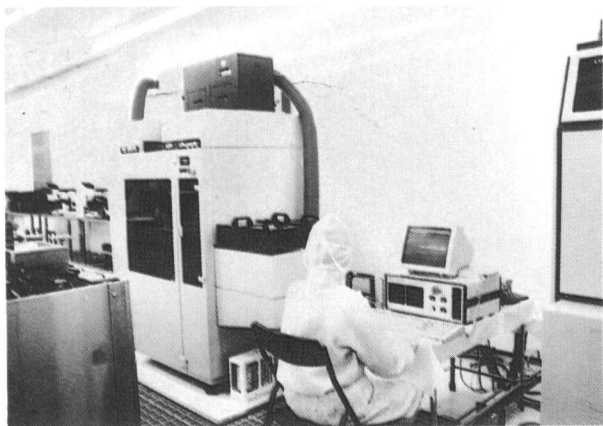
→ 基于0.8微米双层金属布线标准单元，采用全定制方法设计的个人计算机主板上的主频产生电路。

中国科学院微电子中心超大规模集成电路工艺技术研究室是微电子中心从事超大规模集成电路(VLSI)工艺技术研究实验室,在国内首次自主开发成功0.8 $\mu\text{m}$  CMOS 工艺技术,并用此项技术成功地研制出了分别具有单层或双层金属布线的七千门工业用模糊控制器电路及计算机用高速时钟驱动电路芯片。

该项工艺技术是在微电子中心自主建设的0.8微米工艺研究开发线上完成的。该线的净化级别为10级,具有基本的配套的工艺加工及检测设备。为了保证工艺线的稳定运行,该线还承接并完成了多项芯片加工及电路开发任务,努力促进研究开发成果向生产的转化。

此外,在这条线上,研究人员还先后研制成功了0.5微米CMOS工艺的乘法器、0.2微米MOS器件及纳米真空微电子器件。

肖作敏/供稿



净化级别为10级的亚微米VLSI工艺线